

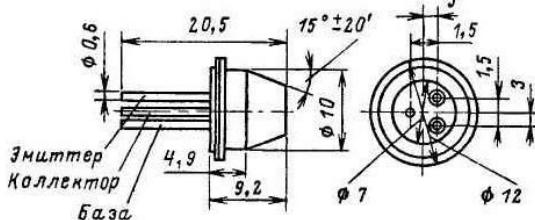
1T403А, 1T403Б, 1T403В, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е, 1T403Ж, 1T403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю

Транзисторы германевые сплавные $p-n-p$ усилительные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах переключения, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока.

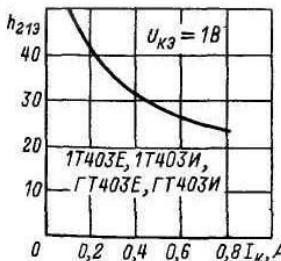
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4 г.



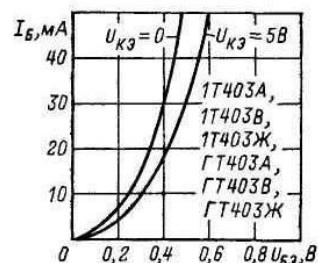
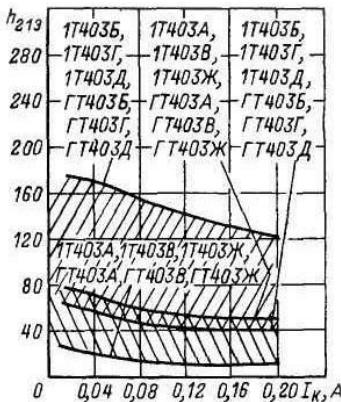
Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А не более	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А не более	0,8 В
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 0,1$ А, $f = 50 \div 300$ Гц:	
1T403А, 1T403В, 1T403Ж, ГТ403А, ГТ403В, ГТ403Ж	20 - 60
1T403Б, 1T403Г, 1T403Д, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д	50 - 150
ГТ403Ю	30 - 60
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 1$ В, $I_3 = 0,45$ А 1T403Е, ГТ403Е, 1T403И, ГТ403И не менее	30
Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала 1T403А, 1T403Б, 1T403В, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Ж при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 0,1$ А, $f = 50 \div 300$ Гц не более:	
при $T = 343$ К	± 30 %
при $T = 213$ К	- 50 %

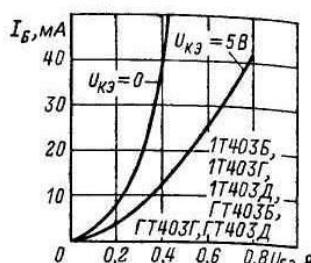


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Зона возможных положений зависимости статического коэффициента тока от тока коллектора.



Входные характеристики



Входные характеристики

Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 1T403Е, 1T403И при $U_{KB} = 1$ В, $I_3 = 0,45$ А не более

при $T = 343$ К

при $T = 213$ К

± 30 %
+ 50 %
- 40 %

8 кГц

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 0,1$ А не менее

Плавающее напряжение эмиттер-база при $U_{KB} = 45$ В 1T403А, 1T403Б, при $U_{KB} = 60$ В 1T403В, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е, при $U_{KB} = 80$ В 1T403Ж, 1T403И

при $T = 343$ К не более

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB\max}$ не более при $T = 298$ К

1T403А, 1T403Б, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е,

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,

ГТ403Ю

при $T = 343$ К

1T403Ж, 1T403И, ГТ403Ж, ГТ403И

при $T = 298$ К

1T403А, 1T403Б, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е,

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,

ГТ403Ю

при $T = 343$ К

1T403Ж, 1T403И, ГТ403Ж, ГТ403И

при $T = 298$ К

1T403А, 1T403Б, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е,

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,

ГТ403Ю

при $T = 343$ К

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{KB} = U_{KB\max}$

1T403А, 1T403Б, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е,

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,

ГТ403Ю

1T403Ж, 1T403И, ГТ403Ж, ГТ403И

при $T = 298$ К

1T403А, 1T403Б, 1T403Г, 1T403Д, 1T403Е,

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е,

ГТ403Ю

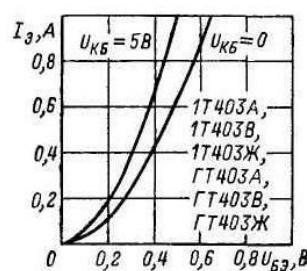
5 мА

6 мА

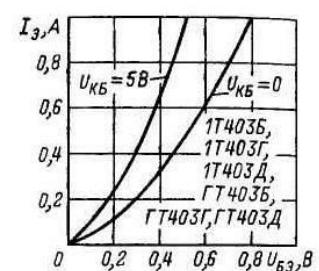
Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	
1T403А, 1T403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	30 В
1T403В, 1T403Е, ГТ403В, ГТ403Е, 1T403Г, 1T403Д, ГТ403Г, ГТ403Д	45 В
1T403Ж, 1T403И, ГТ403Ж, ГТ403И	60 В
Постоянное напряжение коллектор-база	
1T403А, 1T403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	45 В
1T403В, 1T403Е, 1T403Г, 1T403Д, ГТ403В, ГТ403Е, ГТ403Г, ГТ403Д	60 В
1T403Ж, 1T403И, ГТ403Ж, ГТ403И	80 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
1T403Д, ГТ403Д	30 В
Постоянный ток коллектора	
.	1,25 А
Постоянный ток базы	
.	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
с теплоотводом	(358 - T_K) / $R_{T\text{ п-к}}$, Вт
без теплоотвода	(358 - T) / $R_{T\text{ п-с}}$, Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	
1T403В, 1T403Е, ГТ403В, ГТ403Е	15 К/Вт
1T403Д	12 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	
.	100 К/Вт
Температура перехода	
.	358 К
Температура окружающей среды	
1T403	От 213 до 343 К
ГТ403	От 218 до 343 К

Примечание Разрешается производить изгиб и пайку выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с температурой жала паяльника не более 533 К в течение 3 с и групповым или механизированным способом при температуре припоя не более 533 К в течение 5 с



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер